

Секция «Физическая электроника»

Заседание 1

16 ноября 2021, 17:00

2-й учебный корпус, ауд. 431

1. *М.С. Терещенкова, П.К. Афоничева, А.Л. Буляница.* Моделирование гемодинамики при шунтировании сосуда, подверженного тромбозу.
2. *Е.Д. Федоренко, П.А. Карасёв.* Свойства углеродных пленок, выращенных пучком ускоренных ионов C_{60} .
3. *И.Н. Скрипов, К.П. Карасев, Д.А. Стрижкин, П.А. Карасев.* Исследование поверхностных явлений при падении ускоренного иона C_{60} на монокристалл кремния.
4. *С.А. Шестаков, О.А. Подсвилов.* Модификация аморфной углеродной пленки электронным облучением.
5. *Д.А. Пасечник, Д.Б. Дюбо, О.Ю. Цыбин.* Ресурсы компьютерного моделирования ионно-плазменных космических двигателей.
6. *А.И. Клевцов, А.Б. Устинов, В.Н. Петров.* Спин-разрешённая электронная спектроскопия тонких плёнок хрома.

Заседание 2

18 ноября

2021, 16:00

2-й учебный корпус, ауд. 431

1. *А.В. Кудрявцева, О.А. Алексеева, А.А. Набережнов.* Особенности температурной эволюции структуры наночастиц нитрата натрия в ограниченной геометрии при нагреве.
2. *А.Ю. Молоков, Е.Ю. Королева.* Влияние интерфейса на электрические свойства нитрата калия в условиях ограниченной геометрии.
3. *Г.Х.Э. Флорес, А.Е. Ганжа, Р.Г. Бурковский.* Экспериментальное определение и моделирование размерного распределения антисегнетоэлектрических доменов в тонких пленках.
4. *С.А. Удовенко, С.Б. Вахрушев, А.В. Филимонов.* Система для одновременного приложения одноосной деформации и электрического поля к образцам в широком температурном интервале для рентгеноструктурных исследований.
5. *А.Е. Ганжа, Р.Г. Бурковский.* Влияние материала напыленных электродов на электрические параметры тонких пленок $PbZrO_3$.

6. *М.А. Князева, А.Е. Ганжа, Р.Г. Бурковский.* Описание промежуточной антиферродисторсионной фазы в твёрдом растворе $\text{PbHf}_{0.7}\text{Sn}_{0.3}\text{O}_3$ теорией, подобной теории Ландау.

Д.А. Волков, Н.К. Краснова, К.В. Соловьев. Идеально фокусирующие ионные ловушки с наложением осесимметричного электрического и однородного магнитного полей.

Секция «Физика полупроводников и нанoeлектроника»

Заседание 1

18 ноября 2021, 10:00

Microsoft Teams ([ссылка](#))

1. *П.В. Акацевич, Гасумянц В.Э.,* Учет влияния температуры на распределение носителей заряда по энергии при моделировании температурных зависимостей коэффициента термоэдс в высокотемпературных сверхпроводниках.

2. *Е.С. Алимова, И.Б.Захарова, М.А. Елистратова,* Зависимость интенсивности фотolumинесценции 5,10,15,20-тетрафенилпорфиринов от температуры.

3. *А.А. Иванов, В.В. Чалдышев,* Разработка модели для описания оптических свойств резонансных брэгговских структур с квантовыми ямами InGaN/GaN.